文書の積	锺類として,	以下の四つかり	ら一つを選択	してください.							
( 0	) 学術論文()	原著論文),(	)学術論文	(レビュー論文),	(	)技術論文	(原著論文),	( )	)技術論文()	レビュー論文)	

# Ag2Ch (Ch = S, Se, Te)の異常な熱伝導度とそれを利用した固体熱整流素子の開発

Development of high-performance solid-state thermal diodes using unusual behavior of thermal conductivity observed for  $Ag_2Ch$  (Ch = S, Se, Te)

平田 圭佑<sup>a),\*</sup>, 松永 卓也<sup>a)</sup>, Saurabh Singh<sup>a)</sup>, 松波 雅治<sup>a)</sup>, 竹内 恒博<sup>a)</sup>

Keisuke Hirata <sup>a), \*</sup>, Takuya Matsunaga <sup>a)</sup>, Singh Saurabh <sup>a)</sup>, Masaharu Matsunami <sup>a)</sup>, Tsunehiro Takeuchi <sup>a)</sup>

Corresponding Author: sd18429@toyota-ti.ac.jp

a) 豊田工業大学 大学院物質工学分野, 〒468-8511, 愛知県名古屋市天白区久方2丁目12番地1

a) 2-12-1 Hisakata, Tempaku-ku, Nagoya, Aichi, 468-8511, Japan, Graduate School of Engineering, Toyota Technological Institute

#### Abstract

Thermal diodes are a kind of new device which controls the direction and magnitude of heat flow. The performance of thermal diode is evaluated by thermal rectification ratio (*TRR*) defined as  $|J_{large}| / |J_{snall}|$ . Solid-state thermal diodes are made with two materials possessing different temperature dependence of thermal conductivity. Their performance is improved by the significant variation of thermal conductivity with temperature. In this study, therefore, we employed Ag<sub>2</sub>Ch (Ch = S, Se, Te) because these materials are characterized by a drastic change in thermal conductivity due to a structural phase transition in the temperature range of  $100 < T < 200^{\circ}$ C. We prepared Ag<sub>2</sub>Ch samples by means of self-propagating high-temperature synthesis method. The phases involved in the samples were identified using powder X-ray diffraction. We measured temperature dependence of thermal diode consisting of Ag<sub>2</sub>S and Ag<sub>2</sub>Te was designed using the measured thermal conductivity. We experimentally confirmed that the developed thermal diode showed *TRR* = 2.1 ± 0.1 when it was placed between two heat reservoirs kept at  $T_{\rm H} = 200^{\circ}$ C and  $T_{\rm L} = 132^{\circ}$ C.

## Keywords

thermal diode; thermal conductivity; silver chalcogenides; phase transition; self-propagating high-temperature synthesis

Received: 25/03/2019; Accepted: 20/07/2019; Published online: 22/07/2019

## 1. 緒言

省エネルギー社会を構築するために,熱流を制御する技 術の開発が求められている.熱流を制御することができれ ば,利用されずに捨てられている廃熱を,熱が不足してい る箇所に効率的に輸送し,有効利用することが可能となる. 熱整流素子は,熱流の方向によって熱流の大きさが変化す る特徴を有するため,熱流を制御する基盤技術として期待 されている.

定常状態における固体中の熱流密度Jは、フーリエの法則に従い、温度勾配 $-\nabla T$ に比例し、その比例係数が熱伝導度 $\kappa$ である.

$$\boldsymbol{J} = -\kappa \nabla T \tag{1}$$

リに方向依存性を持たせる(熱整流効果を示す)ためには, κに顕著な方向依存性を生み出す機構を用いる必要がある.

現在までに様々な熱整流機構が提案されている<sup>1)</sup>. それ らの中で,再現性および実用性の観点から,我々は高温で 大きな熱伝導度を示す材料Aと低温で大きな熱伝導度を示 す材料 B を組み合わせる機構<sup>2,3)</sup> (Fig. 1) を利用した. Fig. 1 において,材料A を高温側,材料 B を低温側に配置 した場合, A, Bは同時に大きな熱伝導度を示すため, この 配置では, 大きな熱流 *J*<sub>large</sub> が得られる.



Fig. 1. Schematic illustration of a thermal diode consisting of materials A and B showing different temperature dependence of thermal conductivity<sup>2,3)</sup>. Here, *l* represents the total length of thermal diode and *x* is the length ratio of A to *l*.

一方,逆の場合, A, B は同時に小さな熱伝導度を示すため、
得られる熱流は小さくなる (*J*<sub>small</sub>). このとき、素子の性能
は熱整流比 (Thermal rectification ratio : *TRR*) の値によって

評価される.

$$TRR = |\boldsymbol{J}_{\text{large}}| / |\boldsymbol{J}_{\text{small}}|$$
(2)

大きな TRR を得るためには、熱伝導度に顕著な温度依存性 を示す材料を用いる必要がある.しかし、一般的な金属・ 半導体の熱伝導度は室温以上で顕著な温度依存性を示さな いことから、熱整流効果を得ることは困難である.

現在までに、Fig. 1 に模式的に示した機構を利用した熱整 流素子について、*TRR* > 2 を示す例が 3 件報告されている. *TRR* の値および温度域は、それぞれ、(1) *TRR*=2.6 (*T*<sub>H</sub>=44°C、 *T*<sub>L</sub>=7°C)<sup>4</sup>) (2) *TRR*=2 (*T*<sub>H</sub>=45°C、*T*<sub>L</sub>=20°C)<sup>5</sup>) (3) *TRR*=2.2 (*T*<sub>H</sub> = 627°C、*T*<sub>L</sub>=27°C)<sup>6</sup>) である.

(1)および(2) では、高分子材料における固相-液相間の相 変態に伴う熱伝導度の変化を利用しており、*ΔT*=40℃以下 という比較的小さな温度差で大きな *TRR* が得られている. しかし、試料が液相に変化するため、実際に使用するには 特別な容器が必要である.

(3) では、AI 基準結晶の昇温に伴う異常な電子熱伝導度 の増大、および、CuGaTe2の昇温に伴う異常な格子熱伝導度 の減少を利用している.使用温度域において試料は固相で あり、大きな TRR が得られている.しかし、熱整流効果を 得るために $\Delta T = 600^{\circ}$ Cの大きな温度差が必要であり、室温 から 200°Cの廃熱が豊富な温度領域での利用に適していな い.

より実用性の高い熱整流素子を開発するためには、使用 温度域で固体であることに加えて、室温から 200°Cの範囲 で、熱伝導度が大きく変化する材料を用いる必要がある. この要請を満たす材料として、本研究では、銀カルコゲン 化合物 Ag<sub>2</sub>Ch (Ch = S, Se, Te) に着目した. Ag<sub>2</sub>Ch は 100 – 200°Cの間で 1 次の構造相変態を示す. 高温相では Ch 原子 が立方格子を組み、Ag 原子が容易に移動する超イオン伝導 体となることが知られている<sup>7)</sup>. また、低温相から高温相へ の変態に伴い、狭い温度範囲で熱伝導度が大きく変化する ことも報告されている<sup>8,9)</sup>. この特徴を利用することにより、 大きな熱整流効果を得られることが期待される.

本研究では、Ag<sub>2</sub>Ch を用いて、小さな温度差で大きな熱 整流効果を示す素子の開発を目的とし、単相試料作製法の 確立,詳細な物性測定,および,作製した素子の性能評価 を行った.

### 2. 実験方法

粉末状の Ag(純度 99.9%), S(純度 99.99%), Se(純度 99.9%), および, Te(純度 99.9%)を原料として用いた. Ag<sub>2</sub>Ch の組成になるように秤量した原料粉を混合・圧縮成 形した. その後,真空中において自己発熱反応法 (Selfpropagating high-temperature synthesis: SHS 法)により合金化 した. SHS 法によって得られた試料を粉砕し,ホットプレ ス(圧力: 40 MPa,保持時間: 10分,保持温度: 350-650°C) にて成形することにより高密度バルク試料を得た.物性測 定には,密度が理論密度に対して 95%以上の試料を用いた.

試料の相同定は, Bruker 社製 NEW D8 ADVANCE を用い て, 粉末 X 線回折法 (X-ray diffraction: XRD) によって行っ た. 線源は Cu-Kα (40 mA, 40 kV) を用いた.

熱伝導度の温度依存性 *k*(*T*)は、レーザーフラッシュ法 (NETZSCH 社製 LFA457)によって得られた熱拡散率*a*(*T*), 定圧比熱 *Cp*(*T*),および、アルキメデス法によって得られた 試料密度 *d* を用いて、次式から計算した.

$$\kappa(T) = \alpha(T) \times Cp(T) \times d \tag{3}$$

測定には直径 10 mm, 厚み 1.0 mm に成形したペレット状 試料を用いた.

電気抵抗率の温度依存性 $\rho(T)$ は、自作の装置を用いて、真空中で直流 4 端子法によって測定した.得られた $\rho(T)$ から ヴィーデマン・フランツ則を用いて電子熱伝導度 $\kappa_{el}(T)$ を計算した.ローレンツ定数Lは $L=2.44 \times 10^8$  WΩK-2を用いた.

$$\kappa_{\rm el}(T) = LT/\rho(T) \tag{4}$$

得られた*ĸ*(*T*)および*ĸ*<sub>el</sub>(*T*)を用いて,格子熱伝導度*ĸ*<sub>lat</sub>(*T*)を計算した.

$$\kappa_{\rm lat}(T) = \kappa(T) - \kappa_{\rm el}(T) \tag{5}$$

Fig.1に示した機構において、フーリエの法則から素子全体で得られる熱流を計算するには、熱浴温度に対して2つの材料の長さ比xを決定し、それぞれの材料内での温度勾配を求める必要がある.試料側面からの熱の流出はないものと仮定し、実験によって得られた熱伝導度の温度依存性から、Takeuchi らにより提案された方法<sup>10)</sup>を用いて、*TRR*が最大となる熱浴温度、および、材料長さ比を計算した.

Fig.2 に示す自作の熱流測定装置を用いて、定常法により 素子を流れる熱流を測定し、熱整流比 TRR を評価した.



Fig. 2. Schematic illustration of our heat flow measurement system.

ヒーター, Ti ロッド, および, 熱整流素子の各接続界面 に熱伝導グリスを塗り, 1 MPa にて加圧することによって 良好な熱接触を得た. ヒーターはTi ロッドの両側に配置さ れ,同じ熱接触条件で熱流の方向を入れ替えることが可能 である.実験は真空中で行い,アルミシートによって周囲 を覆うことで,輻射の影響を軽減した.素子を流れる熱流 は,低温側に配置されたTi ロッドの断面積,熱伝導度<sup>11)</sup>, および,定常状態における熱電対の温度・取り付け位置か ら,フーリエの法則を用いて計算した.

### 3. 実験結果および考察

合成後に粉砕した試料 (Ag2*Ch*meas.),および,報告されて いる結晶構造 (Ag<sub>2</sub>S<sup>12</sup>), Ag<sub>2</sub>Se<sup>13</sup>), Ag<sub>2</sub>Te<sup>14</sup>)) から計算した <sup>15</sup>XRD パターン (Ag2*Ch*calc.) を Fig. 3 に示す. いずれの試 料においても測定パターンおよび計算パターンが一致した ことから,試料が単相であることを確認した. SHS 法を用 いることで, Ag2*Ch* 単相試料を, 1 試料あたり秤量から 30 分程度で合成できることが明らかになった.

Ag2Ch 試料について, 熱伝導度の温度依存性を Fig. 4 に 示す. 全ての試料において,相変態に伴い,熱伝導度に 2– 3 倍程度の急激な変化が観測された. 個別に準備した試料 間で熱伝導度の挙動および絶対値がよく一致しており,再 現性は十分にあると考える. いずれも固体材料として極め て低い熱伝導度 ( $\kappa$  < 1.5 Wm<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup>)を示し,熱伝導度にピー クを持つことが分かった.また,熱伝導度の温度依存性は, カルコゲン元素の違いによって異なることが分かった.



Fig. 3. Measured XRD patterns of  $Ag_2Ch$  (*Ch* = S, Se, Te). Calculated XRD patterns from the reported crystal structure <sup>12–14</sup>) are also plotted.





Fig. 4. Temperature dependence of the thermal conductivity measured for  $Ag_2Ch$  (Ch = S, Se, Te).

熱伝導度 (Fig. 4\_Sample#1) の計算に用いた熱拡散率お よび定圧比熱の温度依存性を Fig. 5 に示す.全ての試料に おいて,構造相変態に伴う比熱のピークが確認できる.ま た, Ag<sub>2</sub>S では観測されないものの, Ag<sub>2</sub>Se および Ag<sub>2</sub>Te で は,熱拡散率にもピークが観測される.これらの実験事実 から総合的に判断すると, Ag<sub>2</sub>Ch において相変態時に観測 される熱伝導度のピークは,動的測定により生み出される アーティファクトではなく, Ag<sub>2</sub>Ch の物理的な特徴である と判断される.狭い温度範囲で観測される急激な変化であ るため,定常法で観測することは困難であるが,我々はそ の証明にも取り組んでおり,その結果は別論文に報告する 計画である.

Ag2Ch 試料について,電気抵抗率の温度依存性を Fig.6 に 示す. ヴィーデマン・フランツ則を用いて,電子熱伝導度 および格子熱伝導度を計算した結果,低温相および高温相 における熱伝導度の絶対値の違いは電子熱伝導度に起因し ていることが分かった.電気抵抗率に著しい落ち込みがな いことから,熱伝導度の温度依存性に現れるピークは電子 熱伝導度ではなく,格子熱伝導度に起因することが分かっ た.また,いずれの試料においても,高温相,低温相ともに 極めて小さな格子熱伝導度(Klat < 0.5 Wm<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup>)を示すこと が分かった. Ag2Ch の高温相および低温相における極めて 低い格子熱伝導度は,それぞれ、イオン伝導性および格子 の非調和振動に起因していると考えられる.



Fig. 5. Temperature dependence of the thermal diffusivity and specific heat measured for  $Ag_2Ch$  (Ch = S, Se, Te).



Fig. 6. Temperature dependence of the electrical resistivity measured for  $Ag_2Ch$  (*Ch* = S, Se, Te).

熱伝導度の温度依存性 (Fig. 4)から, Ag2S-Ag2Te によって 構成された素子を作製すれば,大きな熱整流効果を得られ ることが期待できる.熱浴温度および材料長さ比をパラメ ータとして,素子から得られる最大の*TRR*を計算した.例 として,Fig. 7 に最大の*TRR*が得られる温度差(高温側 200°C,低温側 132°C)で計算した場合における,*TRR*の材 料長さ比依存性を示す.この計算結果から,材料長さ比が  $L_{Ag_2S}: L_{Ag_2Te} = 56:44$ の場合,最大で*TRR*calc. = 2.3 を示 すことが分かった.



Fig. 7. Thermal rectification ratio (*TRR*) of the thermal diode consisting of Ag<sub>2</sub>S and Ag<sub>2</sub>Te plotted as a function of the length ratio  $x = L_{Ag_2S}/(L_{Ag_2S} + L_{Ag_2Te})$ .

 $L_{Ag_2S}: L_{Ag_2Te} = 56:44$ となるように、試料の厚みをそれぞれ、Ag\_2S:2.23 mm、Ag\_2Te:1.76 mm(直径はともに $\phi$ 10 mm)に調整し、熱整流素子を作製した.さらに、素子を200°Cおよび132°Cの熱浴によって挟み込み、素子を流れる熱流から*TRR*を評価した.Ag\_2Sが高温側、Ag\_2Teが低温側の場合に得られた熱流を $J_{arge}$ 、逆の場合を $J_{small}$ として、Fig.8に、 $|J_{arge}|$ および $|J_{small}|$ を時間の関数としてプロットした.実線は実験から得られた熱流であり、破線は熱伝導度の温度依存性から予測される熱流である.



Fig. 8. Heat flow measured for the prepared thermal diode consisting of Ag<sub>2</sub>S and Ag<sub>2</sub>Te plotted as a function of the heating time. Solid and dashed lines indicate measured and calculated ones, respectively.

熱流の大きさは、いずれも時間に対して一定であり、定 常状態であることを示している.  $|J_{large}|$ および $|J_{small}|$ が示すよ うに、温度勾配の方向を入れ替えるだけで熱流の大きさが 変化し、大きな熱整流効果が得られたことを確認できる. 作製した素子を用いて得られた熱整流比は  $TRR_{meas.} = 2.1 \pm$ 0.1 であった. 100 – 200°Cの範囲において  $TRR_{meas.} > 2$ を示 す全固体熱整流素子は、本研究において試作した Ag2S-Ag2Te が初めてである. なお、測定値 ( $TRR_{meas.}$ ) が 計算値 ( $TRR_{calc.}$ ) よりも若干小さくなった理由として、輻射による 熱流の損失や温度勾配による Ag イオンの偏析などの影響 が考えられる.

我々は、実用性の観点から、より大きな TRR を示し、か つ室温から水の沸点 (100℃) 近傍で動作する熱整流素子 の開発を進めている. Ag<sub>2</sub>Ch は、元素置換によって相変態 温度が変化することが報告されており<sup>16</sup>,これを利用すれ ば熱整流素子の動作温度を任意に制御できるはずである.

また、今回報告した素子の実用化を考えた場合、相変態 に伴う体積変化があるため、クラックの発生などによる破 壊が危惧される.この問題は深刻ではあるものの、Ag2S に ついては、金属のように、延性・展性を示すことが報告さ れており<sup>17)</sup>、この特徴を利用することで、熱膨張や相変態 に伴う歪みに対して耐性をもつ素子を作ることも可能であ ることを付記しておく.

## 4. まとめ

小さな温度差で、大きな熱整流効果を示す固体熱整流素 子の開発を目的とし、Ag2Ch を用いて熱整流素子を試作・ 評価した.その過程で SHS 法による Ag2Ch 単相試料の作 製、および、物性の詳細な温度依存性測定を行った.本研 究の結果、Ag2Ch の熱伝導度は、相変態に伴い、200-300% にも達する大きな変化を示すことを明らかにした.また、 カルコゲンの種類によって異なる挙動を示すこと、および、 異常な熱伝導度の挙動を生み出す際の、格子熱伝導度と電 子熱伝導度の寄与を明らかにした.さらに、Ag2S-Ag2Te に よって構成された全固体熱整流素子は、高温側 200℃と低 温側 132℃の熱浴に挟み込むことで、TRR>2 を示すことを 明らかにした.

#### 5. 参考文献

- 1) G. Wehmeyer et al.: Appl. Phys. Rev. 4, 041304, (2017).
- 2) M. Peyrard: Europhys. Lett. 76, 49, (2006).
- 3) B. Hu *et al.*: *Phys. Rev. E Stat. Nonlinear, Soft Matter Phys.* **74**, 060201, (2006).
- A. L. Cottrill *et al.*: *Adv. Energy Mater.* 8, 1702692, (2018).
- 5) E. Pallecchi et al.: Mater. Horizons 2, 125, (2015).
- T. Takeuchi: Sci. Technol. Adv. Mater. 15, 064801, (2014).
- 7) H. Okazaki: 日本金属学会会報 16, 689, (1977).
- 8) H. Chen et al.: Adv. Mater. 31, 1806518, (2018).
- 9) D. Jung et al.: Mater. Trans. 53, 1216, (2012).
- 10) T. Takeuchi et al.: J. Appl. Phys. 111, 093517, (2012).
- 11) C. Y. Ho et al.: J. Phys. Chem. Ref. Data 1, 279, (1972).
- 12) R. Sadanaga and S. Sueno: Mineral. J. 5, 124, (1967).
- 13) J. Yu and H. Yun: Acta Crystallogr. Sect. E Struct. Reports Online 67, 1, (2011).
- 14) A. van der Lee and J. L. de Boer: Acta Crystallogr. Sect. C Cryst. Struct. Commun. 49, 1444, (1993).
- F. Izumi and K. Momma: *Appl. Crystallogr. XX* 130, 15, (2007).
- 16) S. Miyatani: J. Phys. Soc. Japan 15, 1586, (1960).
- 17) X. Shi et al.: Nat. Mater. 17, 421, (2018).